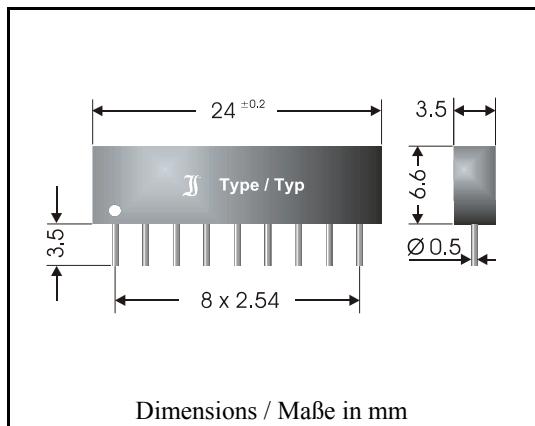
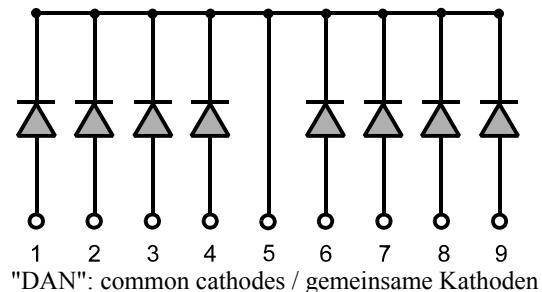
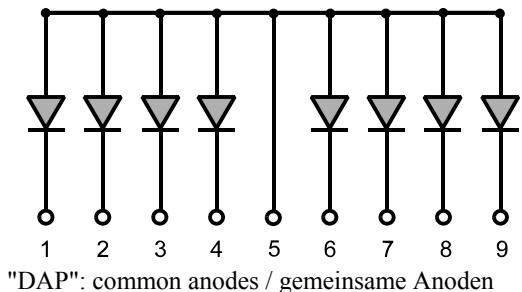


Small Signal Diode Arrays
Dioden Sätze mit Allzweckdioden


Nominal power dissipation Nenn-Verlustleistung	200 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	80 V
9 Pin-Plastic case 9 Pin-Kunststoffgehäuse	24 x 3.5 x 6.6 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	0.6 g
Standard packaging: bulk Standard Lieferform: lose im Karton	see page 22 s. Seite 22


Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
DAN 801	80	80
DAP 801	80	80

Max. average forward rectified current, R-load,
for one diode operation only
per diode for simultaneous operation

$T_A = 25^\circ C$

I_{FAV} 100 mA¹⁾
 I_{FAV} 25 mA¹⁾

Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last,
für eine einzelne Diode
pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb

$T_U = 25^\circ C$

I_{FAV} 100 mA¹⁾
 I_{FAV} 25 mA¹⁾

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle

$T_A = 25^\circ C$

I_{FSM} 500 mA

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten

Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_j T_s	-50...+150°C -50...+150°C
--	----------------	------------------------------

Characteristics	Kennwerte		
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 10 \text{ mA}$	V_F
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 20 \text{ V}$	I_R
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 10 \text{ mA}$ through/über $I_R = 10 \text{ mA}$ to/auf $I_R = 1 \text{ mA}$	t_{rr}	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft		R_{thA}	< 85 K/W ¹⁾

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten